

製品概要

NSBC114EPDXV6: 相補型バイポーラ・デジタル・トランジスタ (BRT)

技術情報は、データシートをご参照ください。

このシリーズのデジタル・トランジスタは、単一のデバイスとその外付け抵抗バイアス・ネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ (BRT) は、単一のトランジスタに、直列ベース抵抗とベース・エミッタ抵抗で構成されるモノリシック・バイアス・ネットワークを組み合わせたものです。BRT は、これらのコンポーネントを 1 つのデバイスに統合して、個々のコンポーネントを省きます。BRT を使用することで、システム・コストと基板スペースの両方を削減できます。

特長

- Simplifies Circuit Design
- Reduces Board Space
- Reduces Component Count
- S and NSV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Polarity	I _c Continuous (A)	V _{BRICE0} Min (V)	h _{FE} Min	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	R1/R2 Typ	V _{CE(off)} Max (V)	V _{CE(on)} Min (V)	Package Type
NSBC114EPDXV6T1G	0.08	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Complementary	0.1	50	35	10	10	1	0.8	2.5	SOT-563
NSBC114EPDXV6T5G	0.08	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Complementary	0.1	50	35	10	10	1	0.8	2.5	SOT-563
NSVBC114EPDXV6T1G	0.088	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	Complementary	0.1	50	35	10	10	1	0.8	2.5	SOT-563

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

12/4/2020 作成